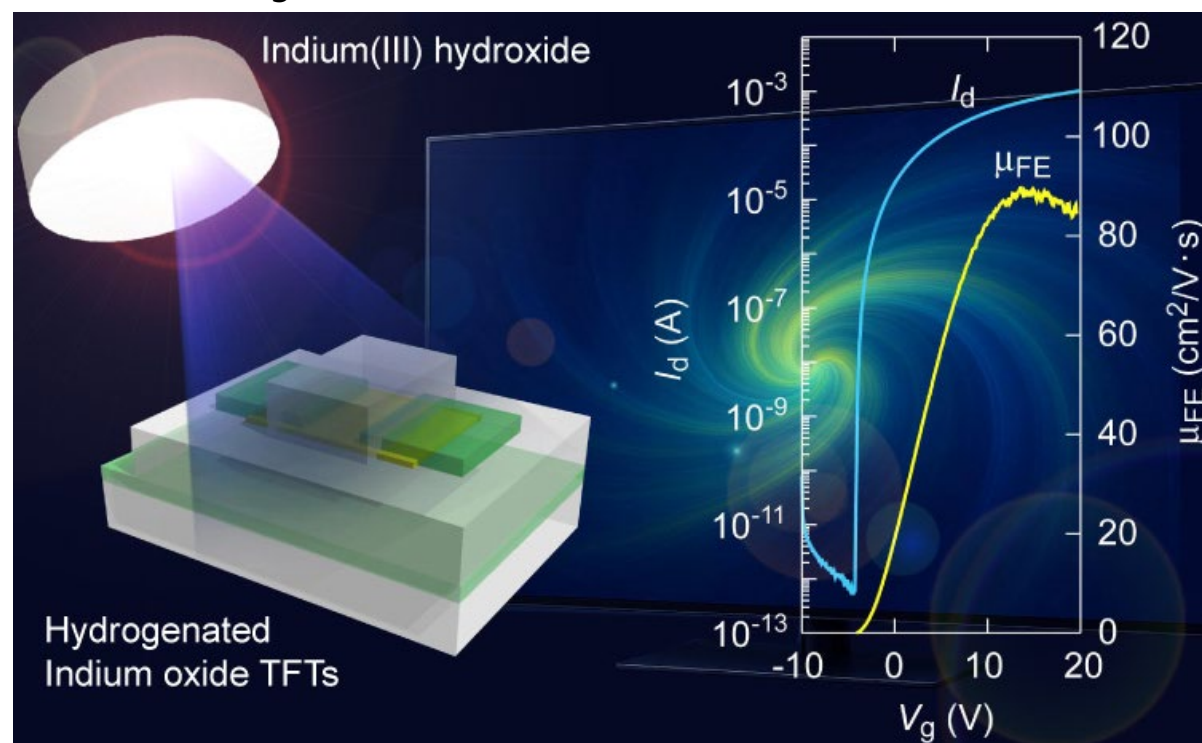


安全かつ簡便に作れる高性能薄膜トランジスタ

(北大院情報) 定平 光、(北大電子研) ゲディヤ・プラシャント、(北大院情報) コン・ヒョンジュン、(北大院工) 三浦 章、(北大電子研) 松尾保孝、太田裕道、
(研究当時・北大電子研、現・高知工科大) 曲 勇作

High-Performance Thin-Film Transistors Manufactured Safely and Easily

Hikaru Sadahira, Prashant Ghediya, Hyeonjun Kong, Akira Miura, Yasutaka Matsuo, Hiromichi Ohta*,
and Yusaku Magari*



北大電子研の太田裕道教授、曲 勇作助教(研究当時、現・高知工科大学 講師)らの研究グループは、危険な水素ガスや複雑な圧力制御を用いずに、電界効果移動度約 $90\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ の高性能薄膜トランジスタの開発に成功しました。

A research group led by Prof. Hiromichi Ohta (RIES, Hokkaido U.), then-Assist. Prof. Yusaku Magari (RIES, Hokkaido U., currently Kochi U. Technol.) has successfully developed high-performance thin-film transistors (TFTs) with a field-effect mobility of approximately $90\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ without using hazardous hydrogen gas or complex pressure control.

By using indium hydroxide as a raw material, hydrogenated indium oxide thin-film transistors with a field-effect mobility of $90\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ has been realized